マルチアルカリ高量子効率・ 高耐久フォトカソードの研究

第11回日本加速器学会 2014年8月11日(月)

清宮 裕史, 栗木 雅夫, 山本 記史, 郭 磊, 横田 温貴(広島大学), 許斐太郎(分子研)

- 2. マルチアルカリ蒸着システム
- 3. カソード性能の評価
- 4. 進行中のプロジェクト
- 5. まとめ

- 2. マルチアルカリ蒸着システム
- 3. カソード性能の評価
- 4. 進行中のプロジェクト
- 5. まとめ

フォトカソード

- ・ 熱力ソードと比べて
 ▶ スポット径、バンチ長などに高い操作性
 ▶ 低エミッタンスが狙える
- 大電流、低エミッタンスの高輝度線形加速器での課題
 - 高い量子効率
 - 長波長励起
 - 高い耐久性







コーネル大学のCsK₂Sb性能

- Si基板
- 緑色レーザー: 520nm, ~2.3W
- スポットサイズ: 4.91mm²
- 引き出し電流値: 60mA
- 真空度:1.5×10-9Pa~4.0×10-9Pa
- 量子効率: 6-7%@520nm
- 1/e lifetime: 30h
- 電荷密度寿命: 1300C/mm²
- 寿命はGaAsの100倍以上

B. Dunham, APL 102,034105(2013)

- 2. マルチアルカリ蒸着システム
- 3. カソード性能の評価
- 4. 進行中のプロジェクト
- 5. まとめ

光学系概要

- 青色レーザー(473nm)と、緑色レーザー(532nm)が使用可能
- 各々量子効率のマッピングが可能
- ビームパワーのサンプル測定により、レーザーのパワー変動補正が可能(本報告の量子効率、寿命測定では未使用)

- 2. マルチアルカリ蒸着システム
- 3. カソード性能の評価
- 4. 進行中のプロジェクト
- 5. まとめ

マルチアルカリ蒸着実験

| マルチアルカリ蒸着手順 | 2012/02/20 | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|---------|
| | 2013/08/29 | | |
| 1. 基板を加熱洗浄(600℃) | 基板温度 | 100°C | |
| 2. 基板を冷ます(100℃) | Sb膜厚 | 102Å | |
| 3. Sb蒸着(目的の膜厚まで) | K膜厚 | 292Å | 7 |
| 4. K蒸着(目的の膜厚まで) | Cs膜厚 | 558Å | ut[u∠ |
| 5. Cs蒸着(QE Max.) 6. 基板温度を室温に戻す | QE@473nm | 5.6 ±0.4% | toCurre |
| BNL、Cornellの生成手順を参考 | QE@532nm | 3.6 ±0.03% | Phc |
| PAC 2011 WEP284, etc. | 電荷量寿命 | 535C | |

- K蒸着中から量子効率を観測
- Cs蒸着時に大幅に上昇
- Cs蒸着停止後も、徐々に上昇
- QE@532nm>3%, QE@473nm>6%

図:成膜時の光電流変化の一例

カソード寿命 二成分モデル

 $\eta(t) = \eta_0 \exp(-t / \tau) \exp(-\rho / \Theta)$

時間寿命:τ 電荷密度寿命: **Θ**

- ビーム引出による劣化 (イオン逆流など)
- 連続レーザー照射による 測定
- 時間成分を補正

 $\eta(t)\exp(+t/\tau) = \eta_0 \exp(-\rho/\Theta)$

時間寿命測定

$$\eta(t) = \eta_0 \exp(-t / \tau)$$

時間寿命て 3500±500 [hour]~5ヶ月

緑色レーザー(532nm) ~0.7mW 総引き出し電荷 < 1mC (平均電流10nA以下) 真空度: 2.0 × 10⁻⁸ Pa 温度: 室温

青色レーザーの場合: ガス吸着などによって表面ポテン シャルが増加しても、その障壁を青 色レーザーの場合は飛び越えられる →寿命が延びる

K thickness [Å]

- アンチモン膜厚200Å程度で高量子効率。
- カリウム膜厚依存性は見えない。

Sb thickness [Å]

• 量子効率は温度に大きく依存し、100℃程度が適切

今後の予定

- レーザー温調、ビームサンプル測定によるパワー補正 を実装し、高精度で量子効率、寿命を測定。
- 各々の波長による、寿命評価。
- 量子効率、寿命の膜厚、蒸着速度、基板温度、真空度 などのパラメーターに対する依存性。

マルチアルカリプラットフォーム

まとめ

- 高量子効率、長寿命を持つマルチアルカリカソード生成法を 確立
- ・時間寿命は3500時間(532nm)と非常に長い。
- 電荷密度寿命 1200 8300C/mm²(473nm)。
- Csを過蒸着することでQE6%以上(473nm)の、一様なカソード。
- カソード性能は成膜時の基板温度に大きく依存。100℃程度 で高量子効率。
- 今後は、再現性の確認、精度の向上とともに、UVSORでの 光電子分光およびLEED測定による最適なカソード生成条件 の同定とその物理的解釈、KEKでの実用化試験に向けた準 備を行う。